



光子学报 » 2013, Vol. 42 » Issue (7): 787-791 DOI: 10.3788/gzxb20134207.0787

光电子学与光电子器件

[最新目录](#) | [下期目录](#) | [过刊浏览](#) | [高级检索](#)

[◀◀ 前一篇](#) | [后一篇 ▶▶](#)

室温中红外HgCdTe光导探测器响应率的温度特性

冯国斌¹, 张检民², 杨鹏翎², 王群书², 安毓英¹

1. 西安电子科技大学 技术物理学院, 西安 710071;

2. 西北核技术研究所 激光与物质相互作用国家重点实验室, 西安 710024

Responsivity Variation with Temperature of Uncooled Mid-infrared HgCdTe Photoconductive Detector

FENG Guo-bin¹, ZHANG Jian-min², YANG Peng-ling², WANG Qun-shu², AN Yu-ying¹

1. Institute of Technical Physics, Xidian University, Xi'an 710071, China;

2. State Key Laboratory of Laser Interaction with Matter, Northwest Institute of Nuclear Technology, Xi'an 710024, China

[摘要](#)

[图/表](#)

[参考文献\(15\)](#)

[相关文章 \(12\)](#)